1. **山口 裕之, 石田 三千雄, 村上 理一, 宮田 憲治, 山口 修二, 村田 貴信 :** 科学技術と倫理, 株式会社 ナカニシヤ出版, 京都, 2007年2月.
2. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1042-1046, 2006.
3. **Daigo KIKUTA, Jin-Ping Ao, Junya MATSUDA *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E89-C,** *No.7,* 1031-1036, 2006.
4. **S. Shimomura, T. Toritsuka, A. Uenishi, Takahiro Kitada *and* S. Hiyamizu :** 1.3μm range effectively cylindrical In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As quantum wires grown on (221)A InP substrates by molecular beam epitaxy, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.32,** *No.1-2,* 346-349, 2006.
5. **Y. Higuchi, S. Osaki, Takahiro Kitada, S. Shimomura, Y. Takasuka, M. Ogura *and* S. Hiyamizu :** Room temperature lasing of GaAs quantum wire vertical-cavity surface-emitting lasers grown on (775)B GaAs substrates by molecular beam epitaxy, *Solid-State Electronics,* **Vol.50,** *No.6,* 1137-1140, 2006.
6. **Jun Inoue, Toshiro Isu, Kouichi Akahane *and* Masahiro Tsuchiya :** Saturable absorption of highly stacked InAs quantum dot layer in 1.5 μm band, *Applied Physics Letters,* **Vol.89,** *No.15,* 151117, 2006.
7. **YOON HAN-KI, KIM HYOUNG O, Dohoon Shin *and* Ri-ichi Murakami :** Nano-Indenter Mechanical Properties of ITO/Glass Thin Film Deposited By DC Magnetron Sputtering Method at Low Temperature, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.20,** *No.25-27,* 4322-4327, 2006.
8. **Z.Y Qiu, Dohoon Shin, K Nakada, Ri-ichi Murakami *and* H.Y Yoon :** Influence of the SiO and SiON Buffer Layer on IZO Thin Films Deposited on PET by Inclination Opposite Target Type DC Magnetron Sputtering Method, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.20,** *No.25-27,* 3640-3645, 2006.
9. **Hiroshi Yamakawa, Ri-ichi Murakami, Daisuke Yonekura, H. S. Lee *and* Nu Yan :** Fatigue Properties of a T Type Welded Joint in a Small Sized Single Pass Boiler Header, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.20,** *No.25n27,* 3836-3841, 2006.
10. **Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of Ion Bombardment on Critical Load of CrN Film Deposited onto Aluminum Alloy by Arc Ion Plating Method, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.20,** *No.25n27,* 3842-3847, 2006.
11. **I. Watanabe, K. Shinohara, Takahiro Kitada, S. Shimomura, Y. Yamashita, A. Endoh, T. Mimura, S. Hiyamizu *and* T. Matsui :** Velocity enhancement in cryogenically cooled InP-based HEMTs on (411)A-oriented substrates, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.53,** *No.11,* 2842-2846, 2006.
12. **H. Sagisaka, Takahiro Kitada, S. Shimomura, S. Hiyamizu, I. Watanabe, T. Matsui *and* T. Mimura :** Suppression of surface segregation of silicon dopants during molecular beam epitaxy of (411)A In0.75Ga0.25As/In0.52Al0.48As pseudomorphic high electron mobility transistor structures, *Journal of Vacuum Science & Technology B,* **Vol.24,** *No.6,* 2668-2671, 2006.
13. **Ri-ichi Murakami, Katsuhiro Fujikawa *and* Daisuke Yonekura :** Improvment of Oxidation Property of SUS304 by Gas barrier Coating, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 1879-1882, 2007.
14. **Satoshi Fukui, Ri-ichi Murakami *and* Daisuke Yonekura :** Effects of Dynamic lon Mixing Coating Condition for Fatigue Properties of Stainless Steel with TiN Film, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 1875-1878, 2007.
15. **Yu Higuchi, Shinji Osaki, Yoshifumi Sasahata, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Mutsuo Ogura *and* Satoshi Hiyamizu :** 830-nm Polarization Controlled Lasing of InGaAs Quantum Wire Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers Grown on (775)B GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.7,* L138-L141, 2007.
16. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Selective generation of quantum beats of weakly confined excitons, *Proceedings of International conference on physics of semiconductors,* **Vol.3,** 78, Viena, Austria, Jul. 2006.
17. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Enhancement of nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films by spectrally rectangle-shape-pulse-excitation, *International conference on nanoscience and technology,* **Vol.600,** 164, Basel, Switzerland, Jul. 2006.
18. **Y. Sasahara, S. Osaki, T. Fujita, A. Uenishi, T. Toritsuka, K. Ohmori, Y. Higuchi, K. Miyajima, Takahiro Kitada, S. Shimomura, T. Itoh *and* S. Hiyamizu :** Room temperature lasing action of vertical cavity surface emitting laser with self-organized InGaAs quantum wire grown on the (775)B InP substrates by molecular beam epitaxy, *33rd International Symposium on Compound Semiconductors,* 31, The University of British Columbia, Vancouver, Canada, Aug. 2006.
19. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *33rd International Symposium on Compound Semiconductors,* 113, Vancouver, Aug. 2006.
20. **Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Surface segregation of indium atoms during molecular beam epitaxy of InGaAs/GaAs superlattices on (n11)A GaAs substrates, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 30, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
21. **I. Watanabe, K. Shinohara, Takahiro Kitada, S. Shimomura, A. Endoh, Y. Yamashita, T. Mimura, S. Hiyamizu *and* T. Matsui :** Thermal stability of Ti/Pt/Au ohmic contacts for cryogenically cooled InP-based HEMTs fabricated on (411)A-oriented substrates by MBE, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 166, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
22. **S. Shimomura, T. Toritsuka, K. Ohmori, A. Uenishi, Takahiro Kitada *and* S. Hiyamizu :** Room temperature operation of 1.2um range self-organized quantum wire lasers grown on a (221)A InP substrates by molecular beam epitaxy, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 327, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
23. **K. Matsuura, D. Kikuta, Jin-Ping Ao, H. Ogiya, M. Hiramoto, H. Kawai *and* Yasuo Ohno :** ICP Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN HFET, *The 2006 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2006),* Yokohama, Sep. 2006.
24. **S. Kusunoki, H. Sagisaka, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** High Schottky AlAs barriers inserted into pseudomorphic InGaAs/InAlAs HEMT structures with (411)A super-flat interfaces grown by MBE, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 70, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
25. **S. Osaki, Y. Higuchi, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Optical properties of GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wires grown on (775)B GaAs substrates by MBE, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 89, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
26. **T. Fujita, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Gain spectra of self-organized GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wire laser grown on (775)B GaAs substrates by molecular beam epitaxy, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 90, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
27. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A Monolithic Cockcroft-Walton Voltage Multiplier Based on AlGaN/GaN HFET Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
28. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-Sensitivity UV Phototransistor with GaN/AlGaN/GaN Gate Epi-Structure, *International Workshop on Nitride Semiconductors 2006,* Kyoto, Oct. 2006.
29. **Nu Yan, Lee I., Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of plasma ion nitriding on the fatigue properties of SCM435 steel, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
30. **Daisuke Yonekura, H. Fukuda *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of bias voltage on fatigue cracking behavior of chromium nitride film deposited on steel, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
31. **Ri-ichi Murakami, K Fujikawa *and* Daisuke Yonekura :** Improvement of Oxidation Property of SUS304 by Gas barrier Coating, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
32. **Ri-ichi Murakami, S Fukui, Daisuke Yonekura *and* Cheol-Mun Yim :** Study of boron-doped diamond films by microwave plasma CVD method, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
33. **Daisuke Yonekura, T Ishikawa *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of ion bombardment process on adhesion between CrN coatings and aluminum alloy, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
34. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Nonlinear optical response of weakly confined excitons, *Kobe Frontier Technology Forum,* 38, Kobe, Nov. 2006.
35. **Yukihiro Tokunaga, Nu Yan, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Thermal fatigue properties of the fin in the boilers, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
36. **Satoshi Fukui, Ri-ichi Murakami *and* Daisuke Yonekura :** Effects of Dynamic Ion Mixing Coating Condition for Fatigue Properties of Stainless Steel with TiN Film, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
37. **Hiroshi Yamakawa, Nu Yan, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Fatigue properties of a T type welded joint in a small-sized single pass boiler header, *Asian Pacific Conference for Fracture and Strength 2006,* Sanya, Nov. 2006.
38. **A. Kanno, Toshiro Isu, O. Kojima, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *5th International Symposium on Nanotechnology,* **Vol.P3-18,** *No.176,* Tokyo, Feb. 2007.
39. **Toshiro Isu, J. Inoue, K. Akahane, H. Sotobayashi *and* M. Tsuchiya :** Nonlinear absorption of highly stacked InAs quantum dot layers on an InP(311) substrate, *Proceedings of SPIE,* **Vol.6393,** 639309-1-639309-9, Washington, D.C., Mar. 2007.
40. **T. Fujita, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Gain Spectra of self-organized GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wire laser groun on (775)B GaAs substrates by moleclar beam epitaxy, *25th Electron Material Symposium,* 306-307, 2006年7月.
41. **S. Osaki, Y. Higuchi, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Optical properties of GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wires grown on (775)B GaAs substrates by MBE, *25th Electron Material Symposium,* 316-317, 2006年7月.
42. **S. Kusunoki, H. Sagisaka, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Pseudomorphic InGaAs/InAlAs HEMT structures with high Schottky AlAs barriers grown on (411)A InP substrates by MBE, *25th Electron Material Symposium,* 82-83, 2006年7月.
43. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons, *25th Electron Material Symposium,* Jul. 2006.
44. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子の超高速非線形光学応答, *応用物理学会中国四国支部学術講演会,* 2006年7月.
45. **岡田 政也, 松浦 一暁, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaNキャップ層ピエゾ電荷を用いたエンハンスメントモードAlGaN/GaN HFET, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
46. **石尾 隆幸, 岡田 政也, 敖 金平, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧の温度依存性の測定, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
47. **山岡 優哉, 岡田 政也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい電圧のゲートストレスバイアス依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
48. **楠 真一郎, 北田 貴弘, 下村 哲 :** (411)A InGaAs/InAlAs変調ドープ歪量子井戸構造における異方性評価, *第67回応用物理学会学術講演会,* 287, 2006年8月.
49. **下村 哲, 笹畑 圭史, 大森 和幸, 鳥塚 哲郎, 上西 敦士, 北田 貴弘, 小倉 睦郎, 冷水 佐壽 :** 自己形成型量子細線のMBE成長とレーザ·面発光レーザへの応用, *第67回応用物理学会学術講演会,* 30, 2006年8月.
50. **尾崎 信二, 樋口 裕, 北田 貴弘, 下村 哲, 冷水 佐壽 :** (775)GaAs基板上にMBE成長した自己形成型GaAs/(GaAs)4(AlAs)2量子細線のフォトルミネッセンス温度依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 1282, 2006年8月.
51. **藤田 剛也, 大森 和幸, 北田 貴弘, 下村 哲, 冷水 佐壽 :** (775)GaAs基板上にMBE成長した自己形成型GaAs/(GaAs)4(AlAs)2量子細線レーザの利得スペクトル, *第67回応用物理学会学術講演会,* 1282, 2006年8月.
52. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子による超高速非線形光学応答, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
53. **菅 良太, 佐藤 弘明, 敖 金平, 小中 信典, 入谷 忠光, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間ミリ波信号伝送, *2006年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2006年9月.
54. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜における弱閉じ込め励起子の量子ビート, *日本物理学会2006年秋季大会,* 2006年9月.
55. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜閉じ込め励起子の時間分解分光, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
56. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子による非線形光学応答, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
57. **石川 陽, 井須 俊郎, 石原 一 :** 共振器QED系での励起子分子効果による2光子非線形性の理論, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
58. **孫 建軍, 村上 理一, 燕 怒, Insup Lee :** SCM435 鋼の超長寿命疲労強度に及ぼすラジカル窒化条件の影響, *日本機械学会講演論文集, No.075-1,* 2007年3月.
59. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 土屋 昌弘 :** 超高速光スイッチに向けたGaAs系弱閉じ込め励起子の光学応答, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
60. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 励起レーザスペクトル制御による弱閉じ込め励起子の非線形光学応答, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
61. **菅野 敦史, Katouf Redouane, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs 弱閉じ込め励起子の時間分解フォトルミネッセンス, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
62. **R. Katouf, A. Kanno, O. Kojima, M. Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs Based devices by wafer fusion, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* Mar. 2007.
63. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子の発光ダイナミクス, *日本物理学会2007年春季大会,* 2007年3月.
64. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子の非線形光学応答に対する励起子準位間干渉効果, *日本物理学会2007年春季大会,* 2007年3月.
65. **岡田 政也, 国貞 雅也, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** GaN/AlGaN/GaNフォトトランジスタを用いたUVセンサ回路, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
66. **奥山 祐加, 菅 良太, 佐藤 弘明, 小中 信典, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における位置ずれの影響, *2007年電子情報通信学会総合大会,* 2007年3月.
67. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子非線形光学応答の複数準位励起効果, *第54回応用物理学関係連合講演会,* 2007年3月.
68. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子の光学応答, *第54回応用物理学関係連合講演会,* 2007年3月.
69. **村上 理一, 他35名 :** 電波吸収体の技術と応用Ⅱ, 株式会社 シーエムシー出版, 東京, 2008年1月.
70. **Issei Watanabe, Keisuke Shinohara, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Akira Endoh, Yoshimi Yamashita, Takashi Mimura, Satoshi Hiyamizu *and* Toshiaki Matsui :** Effects of Heterointerface Flatness on Device Performance of InP-Based High Electron Mobility Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.4B,* 2325-2329, 2007.
71. **Kazuaki Matsuura, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Hiromichi Ogiya, Michihiro hiramoto, Hiroji Kawai *and* Yasuo Ohno :** Inductively Coupled Plasma Reactive Ion Etching with SiCl4 Gas for Recessed Gate AlGaN/GaN Heterostructure Field Effect Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **Vol.46,** *No.4B,* 2320-2324, 2007.
72. **Masaya Okada, Kazuaki Matsuura, Jin-Ping Ao, Yasuo Ohno *and* Hiroji Kawai :** High-sensitivity UV phototransistor with GaN/AlGaN/GaN gate epi-structure, *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science,* **Vol.204,** *No.6,* 2117-2120, 2007.
73. **Jin-Ping Ao, Yoshikazu Matsuda, Yuya Yamaoka *and* Yasuo Ohno :** A monolithic Cockcroft-Walton voltage multiplier based on AlGaN/GaN HFET structure, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.7,* 2654-2657, 2007.
74. **Kim Seong-Hoon, Yoon Han-Ki *and* Ri-ichi Murakami :** The effects of SiO, SiON on IZO thin Film Deposited by DCMG Method, *Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena,* **Vol.124-126,** 455-458, 2007.
75. **Z.Y. Qiu, Ri-ichi Murakami, Daisuke Yonekura *and* J. Ueno :** Effect of the interface on the electrical properties of an Indium zinc oxide /SiOx multilayer, *Thin Solid Films,* **Vol.515,** *No.18,* 7259-7263, 2007.
76. **Kim Do-Hyoung, Yoon Han-Ki, Dohoon Shin *and* Ri-ichi Murakami :** Electromagnetic Wave Shielding Properties of ITO/PET Thin Film by Film Thickness, *Key Engineering Materials,* **Vol.345-346,** 1585-1588, 2007.
77. **Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura *and* Satoshi Hiyamizu :** Surface segregation of indium atoms during molecular beam epitaxy of InGaAs/GaAs superlattices on (n11)A GaAs substrates, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.301-302,** 172-176, 2007.
78. **Issei Watanabe, Keisuke Shinohara, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Akira Endoh, Yoshimi Yamashita, Takashi Mimura, Satoshi Hiyamizu *and* Toshiaki Matsui :** Thermal stability of Ti/Pt/Au ohmic contacts for cryogenically cooled InP-based HEMTs on(411)A-oriented substrates by MBE, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.301-302,** 1025-1029, 2007.
79. **H Yamakawa, Nu Yan, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Fatigue Properties of a T Type Welded Joint in a Small-sized Single Pass Boiler Header, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 2057-2060, 2007.
80. **Y. Tokunaga, Nu Yan, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Thermal Fatigue Properties of the Fin in the Boilers, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 315-318, 2007.
81. **Nu Yan, I. Lee, Ri-ichi Murakami, Daisuke Yonekura, J. Sun *and* S Fukui :** Influence of Plasma Radical Nitriding on Fatigue Properties of SCM435 Steel, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 266-269, 2007.
82. **Nu Yan, H Yamakawa., Ri-ichi Murakami *and* Daisuke Yonekura :** Elevation of fatigue behavior of T-type welded joint in the small-sized single pass boiler, *journal of Pressure Equipment and Systems,* **Vol.5,** 80-83, 2007.
83. **Daisuke Yonekura, Hiroyuki Fukuda *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of Deposition Bias Voltage on Fatigue Cracking Behavior of Chromium Nitride Film Deposited on Steel, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 275-278, 2007.
84. **Ri-ichi Murakami, Shinichiro Fukui, Daisuke Yonekura *and* Cheol-Mun Yim :** Study of Boron-doped Diamond Films by Microwave Plasma CVD Method, *Key Engineering Materials,* **Vol.353-358,** 1883-1886, 2007.
85. **Daisuke Yonekura, Tomoyuki Ishikawa *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of lon Bombardment Process on Adhesion between CrN Coatings and Aluminum Alloy, *Key Engineering Materials,* **Vol.353 358,** 1887-1890, 2007.
86. **Yusuke Kondo, Masaaki Ono, Shunichirou Matsuzaka, Ken Morita, Haruki Sanada, Yuzo Ohno *and* Hideo Ohno :** Multi Pulse Operation and Optical Detection of Nuclear Spin Coherence in a GaAs/AlGaAs Quantum Wells, *Physical Review Letters,* **Vol.101,** *No.20,* 207601, 2008.
87. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Ultrafast Optical Kerr Effect of Excitons Weakly Confined in GaAs Thin Films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.1,* 360-363, 2008.
88. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Decay of Orientational Grating of Weakly Confined Excitons in GaAs Thin Films, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 963-965, 2008.
89. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Effects of Excitation Spectral Width on Decay Profile of Weakly Confined Excitons, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 966-968, 2008.
90. **A. Kanno, R. Katouf, O. Kojima, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki, M. Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Dynamics of weakly confined Excitons in GaAs Thin Films, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 1069-1071, 2008.
91. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Annealing with Ni for ohmic contact formation on ICP-etched p-GaN, *Electronics Letters,* **Vol.44,** *No.2,* 155-157, 2008.
92. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.5,* 1731-1734, Weinheim, May 2007.
93. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Sasaki, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Dynamics of weakly confined Excitons in GaAs Thin Films, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.Mo-P7-08,** 80, Segovia, Jun. 2007.
94. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki *and* M Tsuchiya :** Decay of Orientational Grating of Weakly Confined Excitons in GaAs Thin Films, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.We-P4-49,** 255, Segovia, Jun. 2007.
95. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, R Katouf, M Sasaki *and* M Tsuchiya :** Effects of Excitation Spectral Width on Decay Profile of Weakly Confined Excitons, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.We-P4-50,** 256, Segovia, Jun. 2007.
96. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Ultrafast Optical Kerr Effect of Excitons Weakly Confined in GaAs, *15th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors(HCIS15),* **Vol.WeA-3,** Tokyo, Jul. 2007.
97. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
98. **Cheng-Yu Hu, K. Matsuura, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Ohmic Contact for Dry-Etched p-GaN Realized by High Temperature Annealing, *2007 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Chiba, Aug. 2007.
99. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.MoD P1,** 81, Kyoto, Oct. 2007.
100. **N Niki, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strained Quantum Wells on High Index Substrates, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.ThD P6,** 341, Kyoto, Oct. 2007.
101. **Takahiro Kitada, S Kusunoki, M Kinouchi, Ken Morita, Toshiro Isu *and* S Shimomura :** Isotropic Interface Roughness of Pseudomorphic In0.74Ga0.26As/In0.52Al0.48As Quantum Wells Grown on (411)A InP Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.ThD P5,** 340, Kyoto, Oct. 2007.
102. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, M. Okada, M. Sugimoto, T. Uesugi, T. Kachi *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact Formation to Dry-Etched p-GaN, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors,* Kyoto, Oct. 2007.
103. **Nu Yan, H Yamakawa, Ri-ichi Murakami *and* Daisuke Yonekura :** Elevation of fatigue behavior of T-type welded joint in the small-sized single pass boiler, Changsha,Hunan,China, Oct. 2007.
104. **原内 裕司, 村上 理一, 米倉 大介 :** 熱処理によるTiN薄膜からのTiOxNy薄膜の作製と光分解特性, 2007年5月.
105. **井須 俊郎, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(311)B上のInAs量子ドットの光学異方性, *第3回量子ナノ材料セミナー,* 1-4, 2007年6月.
106. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Interference effects on degenerate four-wave-mixing signals by weakly confined exciton states, *26th Electron Material Symposium, No.G5,* 159-160, Jul. 2007.
107. **T Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada, K Akahane, N Yamamoto *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of InAs quantum dots on an InP(113)B substrate, *26th Electron Material Symposium,* **Vol.G6,** 161-162, Jul. 2007.
108. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Dynamics of excitons weakly confined in GaAs thin films by time-resolved photoluminescence measurements, *26th Electron Material Symposium,* **Vol.G7,** 162-163, Jul. 2007.
109. **井須 俊郎 :** 光電場のナノ空間構造を利用した超高速光スイッチの開発, *ナノテクデバイス研究会,* 68-69, 2007年7月.
110. **Kojima O., Toshiro Isu, Ishi-Hayase J., Kanno A., Katouf R., Sasaki M. *and* Tsuchiya M. :** Interference effects between weakly confined exciton states on exciton dephasing, *ナノテクデバイス研究会,* 126-127, Jul. 2007.
111. **菅野 敦史, Redouane Katouf, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子の発光ダイナミクスおよび，光カー効果を用いた全光スイッチ応用の検討, *ナノテクデバイス研究会,* 128-129, 2007年7月.
112. **Katouf R., Kanno A., Kojima O., Ishi-Hayase J., Tsuchiya M. *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs based photonic devices by wafer fusion, 130-131, Jul. 2007.
113. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** PLによる高指数面上InGaAs歪量子井戸の光学異方性評価, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-5,** 92, 2007年8月.
114. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 大きな非線形光学応答を実現するGaAs/AlAs多層膜構造の検討, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-6,** 93, 2007年8月.
115. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克, 井須 俊郎 :** (113)B InAs量子ドットのフォトルミネッセンスによる光学異方性, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-7,** 94, 2007年8月.
116. **石川 智之, 米倉 大介, 村上 理一 :** CrN薄膜/アルミニウム基板界面の性状に及ぼすイオンボンバード処理の影響, 2007年9月.
117. **長岡 宏樹, 米倉 大介, 村上 理一 :** CrN薄膜被覆鋼の疲労強度に及ぼす膜性状の影響, 2007年9月.
118. **藤川 甲宇, 米倉 大介, 村上 理一 :** ガスバリア膜の被覆によるステンレス鋼の高温酸化特性の改善, 2007年9月.
119. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子系の非線形光学応答に対する残留キャリア効果, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.4a-ZK-12,** 1461, 2007年9月.
120. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(113)B上の積層InAs量子ドットの光学異方性, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.6a-N12,** 1413, 2007年9月.
121. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜構造における光電場強度の増大効果, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-2,** 1418, 2007年9月.
122. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 高指数(11n)面上のInGaAs歪量子井戸の光学異方性, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-3,** 1418, 2007年9月.
123. **菅野 敦史, Redouane Katouf, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** 弱閉じ込め励起子系における光カー効果のピコ秒応答, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-4,** 1419, 2007年9月.
124. **北田 貴弘, 楠 慎一郎, 木内 将登, 森田 健, 下村 哲, 井須 俊郎 :** (411)A InGaAs/InAlAs 変調ドープ歪量子井戸構造における界面ラフネスの異方性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.8a-H-2,** 345, 2007年9月.
125. **大野 泰夫, 山岡 優哉, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平 :** ゲートストレスバイアスによるAlGaN/GaN MIS HFETの電流コラプス評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
126. **野久 保宏幸, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaN MISダイオードによる絶縁膜界面評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
127. **澤田 剛一, 新海 聡子, 敖 金平, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** n‐GaNへの高温処理ZrN電極ショットキー特性, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
128. **胡 成余, 岡田 政也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** Ni処理を用いたドライエッチp‐GaNへの低抵抗オーミック形成, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
129. **敖 金平, 澤田 剛一, 新海 聡子, 岡田 政也, 胡 成余, 廣瀬 和之, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** TiNゲートAlGaN/GaN HFETの特性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* 2007年9月.
130. **奥山 祐加, 柏原 俊彦, 敖 金平, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いたチップ間マイクロ波信号伝送, *2007年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2007年9月.
131. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子の配向緩和, *日本物理学会第62回年次大会,* **Vol.23pPSA-91,** 769, 2007年9月.
132. **岩見 勝弘, 熊井 亮太, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 中河 義典, 井須 俊郎 :** フェムト秒レーザー照射に伴う4H-SiC上での電気伝導度変化の検討, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会講演会予稿集,* **Vol.16,** 129-130, 2007年11月.
133. **菅野 敦史, Katouf Redouane, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子のサブピコ秒光カー効果, *第18回光物性研究会,* **Vol.IIA-48,** 191-194, 2007年12月.
134. **渡辺 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** スペクトル分解反射型ポンプ・プローブ法によるGaAs薄膜中閉じ込め励起子の過渡応答測定, *第18回光物性研究会,* **Vol.IIA-47,** 187-190, 2007年12月.
135. **北田 貴弘, 森田 健, 井須 俊郎 :** 面型超高速光スイッチに向けた半導体多層膜のMBE成長, *応用物理学会中国四国支部研究会,* 2007年12月.
136. **井須 俊郎 :** ナノ半導体による新規光デバイスの創製, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2007年12月.
137. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(113)B基板上InAs量子ドットのフォトルミネッセンス光学異方性, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-11,** 2007年12月.
138. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 高指数GaAs面上InGaAs歪量子井戸の光学異方性, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-12,** 2007年12月.
139. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 大きな非線形光学応答のためのGaAs/AlAs 多層膜構造の光電場強度増大効果, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-13,** 2007年12月.
140. **北田 貴弘, 楠 真一郎, 木内 将登, 森田 健, 下村 哲, 井須 俊郎 :** 電子移動度によるInGaAs/InAlAs へテロ界面の異方性評価, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-14,** 2007年12月.
141. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, Katouf Redouane, 菅野 敦史, 土屋 昌弘 :** GaAs閉じ込め励起子ポラリトンによる超高速光スイッチ, *JSTナノテクノロジー分野別バーチャルラボ成果報告会,* PB6-1, 2008年1月.
142. **伊藤 秀起, 高橋 健介, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** マイクロ波整流用GaNショットキーダイオードの特性評価, *2008年電子情報通信学会総合大会,* 2008年3月.
143. **渡部 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における複数準位励起下での閉じ込め励起子の過渡反射スペクトル, *日本物理学会第63回年次大会, No.26a-PS-27,* 2008年3月.
144. **カトフ レドワン, 菅野 敦史, 山本 直克, 井須 俊郎, 外林 秀之, 土屋 昌弘 :** GaAs ナノ細線光導波路の作製と評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
145. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs (001)および(113)B基板上へのInAs量子ドットのMBE成長と光学特性評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
146. **森田 健, 神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜における時間分解非線形光学応答, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
147. **小島 磨, 宮川 歩弓, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の超高速非線形応答の励起光強度依存性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
148. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 有限障壁ポテンシャルを考慮した高指数GaAs (11n)A基板上のInGaAs歪量子井戸の光学異方性評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
149. **神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** AlAs/Al0.3Ga0.7Asダブルエッチストッパー構造を有するGaAs/AlAs多層膜構造の作製, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
150. **北田 貴弘, 神原 敏之, 森田 健, 井須 俊郎 :** マトリックス法によるGaAs/AlAs多層膜構造の光カー信号強度のシミュレーション, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
151. **菅野 敦史, カトフ レドワン, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** 多連パルス入射時の弱閉じ込め励起子光カー効果サブピコ秒応答, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
152. **胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** p-基板層付きAlGaN/GaN HFETのVt-Vsub特性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
153. **高橋 健介, 伊藤 秀起, 原内 貴司, 岡田 政也, 胡 成余, 敖 金平, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫, 井川 裕介 :** GaNを用いたマイクロ波整流用ショットキーバリアダイオード, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
154. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast response induced by interference effects between weakly confined exciton states, *Journal of the Physical Society of Japan,* **Vol.77,** *No.4,* 044701, 2008.
155. **Masaya Okada, Hideki Ito, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Mechanism of AlGaN/GaN Heterostructure Field-Effect Transistor Threshold Voltage Shift by Illumination, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.4,* 2103-2107, 2008.
156. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2858-2860, 2008.
157. **Takahiro Kitada, S Kusunoki, M Kinouchi, Ken Morita, Toshiro Isu *and* S Shimomura :** Isotropic Interface Roughness of Pseudomorphic In0.74Ga0.26As/In0.52Al0.48As Quantum Wells Grown on (411)A InP Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2753-2755, 2008.
158. **Nobuyoshi Niki, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strained Quantum Wells on High Index Substrates, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2756-2759, 2008.
159. **Nu Yan, Sun Jianjun, Lee Insup *and* Ri-ichi Murakami :** Effect of plasma nitrocarburizing on fatigue strength of SCM435 steel, *Journal of Pressure Equipment and Systems,* **Vol.6,** 25-28, 2008.
160. **Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao, Masaya Okada *and* Yasuo Ohno :** A Study on Ohmic Contact to Dry-Etched p-GaN, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1020-1024, 2008.
161. **Jin-Ping Ao, Yuya Yamaoka, Masaya Okada, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Investigation on Current Collapse of AlGaN/GaN HFET by Gate Bias Stress, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E91-C,** *No.7,* 1004-1008, 2008.
162. **Pangpang Wang, Lumei Gao, Zhiyong Qiu, Xiaoping Song, Liqun Wang, Sen Yang *and* Ri-ichi Murakami :** A multistep ac electrodeposition method to prepare Co nanowires with high coercivity, *Journal of Applied Physics,* **Vol.104,** *No.6,* 064304-064308, 2008.
163. **Takahiro Kitada, Toshiyuki Kanbara, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs Multilayer Cavity with Self-Assembled InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Ultrafast All-Optical Switching Applications, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.9,* 092302, 2008.
164. **Takahiro Kitada, Nobuyoshi Niki, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of(11n)-Oriented InGaAs Strained Quantum Wells with Finite Barrier Potential Calculated with Mixing Effects of the Spin-Orbit Split-Off Band, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.10,* 7839-7841, 2008.
165. **R. Katouf, N. Yamamoto, A. Kanno, N. Sekine, K. Akahane, H. Sotobayashi, Toshiro Isu *and* M. Tsuchiya :** Ultrahigh Relative Refractive Index Contrast GaAs Nanowire Waveguides, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.12,* 122101, 2008.
166. **Osamu Kojima, Ayumi Miyagawa, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Ultrafast all-optical control of excitons confined in GaAs thin films, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.11,* 112401, 2008.
167. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 72-74, 2008.
168. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *Semiconductor Technology,* **Vol.33,** *No.12,* 75-79, 2008.
169. **Ken Morita, Kanbara Toshiyuki, Yano Shinsuke, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Asymmetric temporal profile of optical Kerr signal from GaAs/AlAs multilayer with /2 phase shift layer, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.1,* 137-140, 2009.
170. **O Kojima, A Miyagawa, T Kita, Toshiro Isu *and* O Wada :** Optical Cancellation of exciton population in GaAs thin films, *3rd International Laser, Light-Wave and Microwave Conference 2008,* **Vol.24-TP1-1,** Yokohama, Apr. 2008.
171. **R. Katouf, A. Kanno, N. Yamamoto, N. Sekine, K.T. Liang, K. Sasagawa, K. Akahane, Toshiro Isu, H. Sotobayashi *and* M. Tsuchiya :** 15 dB cross loss modulation by cw pump injection of mW-class in 1.5-mm long nano-wire waveguide, *Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO2008),* San Jose, U.S.A., May 2008.
172. **Ken Morita, Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Asymmetric temporal profile of optical Kerr signal from GaAs/AlAs multilayer with λ/2 phase shift layer, *The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON2008),* **Vol.OP-IV-03,** Kyoto, Jun. 2008.
173. **O. Kojima, A. Miyagawa, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Optical control of residual excitons for ultrafast nonlinear response in GaAs thin films, *The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON2008),* **Vol.P-53,** Kyoto, Jun. 2008.
174. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2858-2860, Jul. 2008.
175. **S. Watanabe, O. Kojima, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Transient reflectivity response with negative time delay caused by femtosecond pulse propagation in GaAs thin films, *Third International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications,* Edmonton, Canada, Jul. 2008.
176. **Takahiro Kitada, T. Mukai, T. Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Fast carrier relaxation of self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barriers for ultrafast nonlinear optical switching applications, *15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2008), No.3-V FA1.6,* Vancouver, Aug. 2008.
177. **T. Mukai, T. Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of carrier relaxation in self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barrier layers, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.E-1-4,** Tsukuba, Sep. 2008.
178. **T. Kanbara, S. Nakano, S. Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced two-photon absorption in a GaAs/AlAs multilayer cavity, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.E-2-5,** Tsukuba, Sep. 2008.
179. **T. Takahashi, .T Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Molecular beam epitaxy of self-assembled InAs quantum dots on (001) and (113)B GaAs substrates under a slow growth rate condition, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.F-5-2,** Tsukuba, Sep. 2008.
180. **Ken Morita, T. Kanbara, S. Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities for a short pulse, *35th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2008),* **Vol.P35,** Rust,Germany, Sep. 2008.
181. **K. Takahashi, Jin-Ping Ao, Y. Ikawa, C. -Y. Hu, H. Kawai, N. Shinohara, N. Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
182. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Daigo Kikuta, Masahiro Sugimoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** VT-VSUB Characterization of AlGaN/GaN HFET with Regrown Epi-layer on p-GaN, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
183. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *The 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2008),* Tsukuba, Sep. 2008.
184. **Shamimur Md. Rahman, T. Md. ShamimurKatsuma Rahman, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Effect of Bias Voltage on Fatigue Behavior of CrN Film Deposited on Ti-Al-4V Alloy, *Proceedings of the 3rd International Conference on Material and Processing 2008,* Chicago, Oct. 2008.
185. **Qiu Zhiyong, Wang Pangpang *and* Ri-ichi Murakami :** THE PREPARATION AND PROPERTIES OF ZINC OXIDE/SILVER/ZINE OXIDE MULTILAYER TRANSPARENT CONDUCTIVE OXIDE THIN FILMS DEPOSITED BY A D.C. MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM, *Proceedings of the 3rd International Conference on Material and Processing 2008,* Chicago, Oct. 2008.
186. **Daisuke Yonekura, T. Ishikawa *and* Ri-ichi Murakami :** Effect of Ion Bombardment on Adhesive Strength of Hard Thin Film Deposited on Aluminum Alloy, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
187. **Masaya Takahashi, Daisuke Yonekura, Ri-ichi Murakami *and* Masahiro Katoh :** The influence of surface roughness of substrate on SiO2 powders-steel adhesion, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
188. **Y. Nishioka, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of interlayers on tribological properties of CrN deposited on aluminum alloy, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
189. **Y. Harauchi, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Photocatalytic Properties of a TiOxNy Film Obtained by Oxidation of TiN Film, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
190. **K. Oka, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Electrochemical Properties of Boron-doped Diamond Deposited by Microwave Plasma CVD Method, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
191. **K. Kario, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Oxygen Solubility and Diffusibility of SiOxNy Films Deposited by DC Magnetron Sputtering, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
192. **H. Nagaoka, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Fatigue Properties of Medium Carbon Steel Deposited with CrN and TiAlN Film, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
193. **T. Katsuma, Shamimur Md. Rahman, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Evaluation of Crack Initiation and Fatigue Behavior of CrN Film Deposited on Ti-6Al-4V Alloy, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
194. **Wang PangPang, Qiu Zhiyong, Gao Lumei, Wang Liqun, Ri-ichi Murakami *and* Song Xiaoping :** Preparation and field emission properties of Ag nanorod arrays by AAO template synthesis method, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
195. **Wang PangPang, Gao Lumei, Wang Liqun, Yang Sen, Song Xiaoping *and* Ri-ichi Murakami :** Magnetic properties of FeNi nanowires array assembled by AC electrodeposition on porous AAO template, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
196. **Lee Chan-joo, Ri-ichi Murakami *and* Suh Chang-min :** Fatigue properties of aluminum alloy(A6061-T6) with ultrasonic nanocrystal surface modification, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
197. **Cao Xiaojian, Ri-ichi Murakami *and* Wang Qingyuan :** Fatigue properties of Ti-6AI-4V subjected to 0.9% physiogical saline solution, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
198. **Cao Xiaojian, Ri-ichi Murakami *and* Wang Qingyuan :** Fatigue properties of Ti-6AI-4V sterilized by 75% medical alcohol, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
199. **Ri-ichi Murakami *and* Shin Do-Hoon :** Effect of process parameters on electrical, optical and electromagnetic shielding properties on IZO films produced by Inclination Opposite Target Type DC Magnetron Sputtering at room temperature, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
200. **Fukui Satoshi, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of deposition conditios on ftigue properties of martensitic steel with TiN film coated by Arc Ion plating method, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
201. **Yim Cheolmun *and* Ri-ichi Murakami :** Chemical Modification of Diamond Films on Pure Titanium Deposited By MPCVD Method, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
202. **Yoon H.K., Ri-ichi Murakami *and* Oiu Z. :** Patterning of indium Zn oxide by photolithography for fabrication of flat-pannel displays, *International Conference on Advanced Materials Development & Performance 2008,* Beijing, Oct. 2008.
203. **Heng-Yu Xu, Jin-Ping Ao, Hui Yu, Cheng-Yu Hu *and* Yasuo Ohno :** Device Isolation for AlGaN/GaN HFET Utilizing Heavy Metal Diffusion, *IEEE Nanotechnology Materials and Device Conference 2008 (NMDC2008),* Kyoto, Oct. 2008.
204. **Ikuo Awai, Kunihito Hori, Yuka Okuyama *and* Yasuo Ohno :** Non-contact Signal Transmission Based on Open Ring Resonator BPF, *Proceedings of the 38th European Microwave Conference,* Amsterdam, Oct. 2008.
205. **Nu Yan, Sun Jianjun, Insup Lee *and* Ri-ichi Murakami :** Effect of plasma nitrocarburizing on fatigue strength of SCM435 steel, *Journal of Pressure Equipment and Systems,* **Vol.6,** 25-28, Oct. 2008.
206. **Naoki Shinohara, Yushi Miyata, Tomohiko Mitani, Naoki Niwa, Kenji Takagi, Kenichi Hamamoto, Satoshi Ujigawa, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** New Application of Microwave Power Transmission for Wireless Power Distribution System in Buildings, *Asia Pacific Microwave Conference 2008,* Hong Kong, Dec. 2008.
207. **Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-resolved two-photon absorption measurements of GaAs/AlAs multilayer with λ/2 GaAs layer, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.J13,* 211, Jul. 2008.
208. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication and optical properties of self-assembled InAs quantum dots grown on GaAs(001) and (113)B substrates, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.K9,* 235, Jul. 2008.
209. **S. Watanabe, O. Kojima, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation effect on transient response of excitons confined in GaAs thin films, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.J14,* 213, Jul. 2008.
210. **日下 一也, 高木 均, 米倉 大介, 長町 拓夫, 英 崇夫 :** 設計-製作分離型ものづくり実習の試み, *平成20年度工学・工業教育研究講演会 講演論文集,* 66-67, 2008年8月.
211. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットの分子線エピタキシャル成長と光学特性評価, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Ep-05,** 2008年8月.
212. **神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造の作製と二光子吸収特性評価, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-07,** 2008年8月.
213. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlGaAs 量子井戸の二光子励起フォトルミネッセンス, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-05,** 2008年8月.
214. **高橋 朋也, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs 基板上InAs 量子ドットの分子線エピタキシャル成長とフォトルミネッセンス測定, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Ep-06,** 2008年8月.
215. **矢野 慎介, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜共振器構造におけるQ値と光カー信号強度, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-09,** 2008年8月.
216. **敖 金平, 許 恒宇, 于 僡, 胡 成余, 大野 泰夫 :** Ni拡散によるAlGaN/GaN HFET素子分離, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
217. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET VT-VSUB特性を用いたp-GaN上バッファ層の評価, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
218. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ表面負帯電におけるDC特性の解析, *第69回応用物理学会学術講演会,* 2008年9月.
219. **高橋 朋也, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットのMBE成長, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(2a-CF-16),* 2008年9月.
220. **今津 晋二郎, 松木 豊和, 毛利 如良, 藤田 剛也, 北田 貴弘, 下村 哲 :** (775)B GaAs基板上にMBE成長したGaAs/(GaAs)4(AlAs)2自己形成型量子細線レーザのゲインスペクトル3, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3p-ZQ-6),* 2008年9月.
221. **神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 二光子共鳴量子井戸を有するGaAs/AlAs 多層膜共振器構造の作製, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-2),* 2008年9月.
222. **森田 健, 神原 敏之, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器の非対称時間分解光カー信号, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-3),* 2008年9月.
223. **矢野 慎介, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造における光カー信号強度の層数依存性, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-4),* 2008年9月.
224. **北田 貴弘, 神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造の光カー信号強度のQ 値依存性のシミュレーション, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-5),* 2008年9月.
225. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (001)量子井戸における二光子吸収の光学異方性, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-6),* 2008年9月.
226. **小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の密度制御, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-7),* 2008年9月.
227. **岩見 勝弘, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 中河 義典, 井須 俊郎, 齋藤 伸吾 :** フェムト秒レーザー照射により改質されたSiCの電気伝導特性, *第69回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.69,** *No.3,* 999, 2008年9月.
228. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットの高速キャリア緩和, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(4p-ZQ-16),* **Vol.Ep-05,** 2008年9月.
229. **森田 健, 仁木 伸義, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 二光子励起フォトルミネッセンス分光におけるGaAs/AlGaAs量子井戸の光学異方性, *第19回光物性研究会,* **Vol.3B-100,** 402-405, 2008年12月.
230. **渡部 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子ポラリトン伝播効果, *第19回光物性研究会,* **Vol.3B-105,** 422-425, 2008年12月.
231. **向所 明里, 向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As 層に埋め込んだInAs量子ドットの作製とその光学特性, *第29回レーザー学会学術講演会, No.F-10pVI-2,* 2009年1月.
232. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs量子井戸における二光子吸収の偏光方向異方性, *第29回レーザー学会学術講演会, No.F-10pVI-3,* 2009年1月.
233. **熊井 亮太, 富田 卓朗, 森田 健, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎 :** 100kHzフェムト秒レーザーを用いた半導体へのナノ周期構造の作製, *レーザー学会学術講演会第29回年次大会講演予稿集,* **Vol.29,** 125, 2009年1月.
234. **井須 俊郎 :** ナノ半導体による新規光デバイスの創製に向けて, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
235. **北田 貴弘 :** 超高速光スイッチに向けたInAs量子ドットのMBE成長, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
236. **森田 健 :** GaAs/AlAs多層膜共振器構造の非線形光学応答, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
237. **宮田 侑是, 篠原 真毅, 三谷 友彦, 丹羽 直幹, 高木 賢二, 浜本 研一, 宇治 川智, 高橋 健介, 敖 金平, 大野 泰夫 :** GaNショットキーダイオードを用いた大電力レクテナの研究開発, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
238. **阿部 まみ, 奥山 祐加, 倉本 健次, 黒田 健太郎, 佐藤 弘明, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における損失の検討, *2009年電子情報通信学会総合大会,* 2009年3月.
239. **小島 磨, 渡部 真吾, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子過渡応答に対する空間コヒーレンス効果, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
240. **井須 俊郎, 田中 文也, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘 :** 2つの共振器モードを実現するGaAs/AlAs多層膜結合共振器構造, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
241. **田中 文也, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造における第二高調波・和周波発生, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
242. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和InGaAsバリア層に埋め込んだInAs量子ドットのキャリア緩和におけるドーピング効果, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
243. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 共振器層に過飽和吸収特性を有するGaAs/AlAs多層膜共振器構造, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
244. **森田 健, 高橋 朋也, 神原 敏之, 向井 拓也, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層中のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器における光カー信号, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
245. **高橋 朋也, 向井 拓也, 向所 明里, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器のMBE成長, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
246. **澤田 剛一, 敖 金平, 許 恒宇, 高橋 健介, 胡 成余, 河合 弘治, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** p型表面層を持つマイクロ波整流用GaNショットキーバリアダイオード, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
247. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETにおける仮想ゲート型電流コラプスのSPICE回路モデル, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
248. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 菊田 大悟, 杉本 雅裕, 大野 泰夫 :** p層上デュアルゲートAlGaN/GaN HFETにおけるアバランシェホール電流の測定, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
249. **胡 成余, 中谷 克俊, 敖 金平, 大野 泰夫, 菊田 大悟, 杉本 雅裕 :** VT-VSUB特性を用いたp-GaN上のAlGaN/GaN HFETバッファ層評価, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
250. **井川 裕介, 湯浅 頼英, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのゲートエッジ負帯電による電流コラプスの2次元数値解析, *電気学会電子材料研究会,* 2008年11月.
251. **米倉 大介 :** コーティング材の転がり摩耗損傷および薄膜の密着強度, *第128回破壊力学部門委員会講演会資料,* **Vol.57,** *No.2,* 49-58, 2008年11月.
252. **Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Future Applications of GaN Electron Devices, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
253. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Refractory Metal Nitride Schottky Contact on GaN, *15th National conference on Compound Semiconductor Materials, Microwave Devices and Optoelectronic Devices (China),* Nov. 2008.
254. **大野 泰夫 :** 共振器結合を用いたワイアレス電力伝送, *日本機械学会マイクロナノ工学専門会議マイクロエネルギー研究会第三回会合,* 2009年3月.
255. **Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** GaN-based Schottky Diodes, Handbook of Light Emitting and Schottky Diode Research, Nova Science Publishers, Hauppauge, May 2009.
256. **小島 磨, 井須 俊郎 :** Dynamics of Excitons Confined in Semiconductor Thin Films, High-Power and Femtosecond Lasers : Properties, Materials and Applications (Lasers and Electro-optics Research and Technology), 2009年7月.
257. **Ken Morita, Haruki Sanada, Shunichirou Matsuzaka, Yuzo Ohno *and* Hideo Ohno :** Intersubband exchange interaction induced by optically excited electron spins in GaAs/AlGaAs quantum wells, *Applied Physics Letters,* **Vol.94,** *No.16,* 162104, 2009.
258. **Shingo Watanabe, Osamu Kojima, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Transient reflectivity response with negative time delay caused by femtosecond pulse propagation in GaAs thin films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.S1,* S139-S142, 2009.
259. **Takuya Mukai, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of carrier relaxation in self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barrier layers, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C106, 2009.
260. **Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced two-photon absorption in a GaAs/AlAs multilayer cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C105, 2009.
261. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Properties of Self-Assembled InAs Quantum Dots Grown on (001) and (113)B GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy under a Slow Growth Rate Condition, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C128, 2009.
262. **Ken Morita, Toshiyuk Kanbara, Shinsuke Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities for a short pulse, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.6,* 1420-1423, 2009.
263. **Kensuke Takahashi, Jin-Ping Ao, Yusuke Ikawa, Cheng-Yu Hu, Hiroji Kawai, Naoki Shinohara, Naoki Niwa *and* Yasuo Ohno :** GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C095, 2009.
264. **Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao, Ikuo Awai *and* Yasuo Ohno :** Wireless Inter-Chip Signal Transmission by Electromagnetic Coupling of Open-Ring Resonators, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C025, 2009.
265. **Takahiro Kitada, Takuya Mukai, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Fast carrier relaxation of self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barriers for ultrafast nonlinear optical switching applications, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.311,** *No.7,* 1807-1810, 2009.
266. **Takahiro Kitada, Toshiyuki Kanbara, Shinsuke Yano, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked Enhancement of Optical Kerr Signal in Proportion to Fourth Power of Quality Factor of a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.8,* 080203, 2009.
267. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced Optical Kerr Signal of GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers, *Applied Physics Express,* **Vol.2,** *No.8,* 082001, 2009.
268. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures for terahertz emission devices, *Applied Physics Letters,* **Vol.95,** *No.11,* 111106, 2009.
269. **Satoshi Fukui, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** EFFECT OF BIAS VOLTAGE ON THE FATIGUE LIFE OF MARTENSITIC STAINLESS STEEL WITH TiN FILM COATED USING ARC ION PLATING METHOD, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.23,** *No.15,* 3213-3220, 2009.
270. **Pangpang Wang, Dongyan Zhang, Kim Hun Dong, Qiu Zhiyong, Gao Lumei, Ri-ichi Murakami *and* Xiaoping Song :** Enhancement of light transmission by coupling to surface plasmon polaritons of a layer-plus-islands silver layer, *Journal of Applied Physics,* **Vol.106,** *No.10,* 103103-103104, 2009.
271. **Daisuke Yonekura, Yuji Harauchi, Syuhei Katsura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of Heat Treatment Conditions on Photocatalytic Properties of Oxidized TiN Film, *Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering,* **Vol.3,** *No.12,* 1238-1248, 2009.
272. **Kim Dong-Hun, Ri-ichi Murakami, Kim Yun-Hae, Moon Kyung-Man, An Seung-Jun, Kim Tae-Hyun *and* Pangpang Wang :** The Characteristics of Multilayer Thin Films Deposited with Metal Thin Film(Ag, Al, Cu), *Advanced Materials Research,* **Vol.97-101,** 1768-1771, 2010.
273. **Takuro Tomita, Masahiro Iwami, Minoru Yamamoto, Manato Deki, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shingo Saito, Kiyomi Sakai, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Electronic properties of femtosecond laser induced modified spots on single crystal silicon carbide, *Materials Science Forum,* **Vol.645-648,** 239-242, 2010.
274. **Pankaj Koinkar *and* Ri-ichi Murakami :** A New Approach on Engineering Education in Global Graduate School Program, *Journal of University Education and Research,* **Vol.7,** 85-93, 2010.
275. **Atsushi Kanno, Redouane Katouf, Osamu Kojima, Junko Ishi-Hayase, Masahiro Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr response to multi pump pulses on GaAs weakly confined exciton, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.6,* 1509-1512, Wiley-VCH, Apr. 2009.
276. **Daisuke Yonekura, Yuji Harauchi, Syuhei Katsura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence Of Heat Treatment Conditions on Photocatalytic Properties of Oxidized TiN film, *Proceedings of 4th RAMM and 2nd ASMP 2009,* Penang, Jun. 2009.
277. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai *and* Yasuo Ohno :** Schottky Contacts of Reactive Sputtering Refractory Metal Nitrides on Gallium Nitride, *The 10th International Symposium on Sputtering & Plasma Processes,* 433-436, Kanazawa, Jul. 2009.
278. **Takahiro Kitada, A. Mukaijyo, T. Takahashi, T. Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Doping effect on photocarrier lifetime in InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers grown by molecular beam epitaxy, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Mo-mP54,** 66, Kobe, Jul. 2009.
279. **Ken Morita, T. Takahashi, T. Kanbara, S. Yano, T. Mukai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Large optical Kerr signal of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Mo-mP59,** 71, Kobe, Jul. 2009.
280. **S. Shimomura, T. Fujita, S. Imadu *and* Takahiro Kitada :** Anisotropic modal gain spectra of GaAs self-assembled quantum-wire laser structures on (775)B GaAs substrates, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Tu-mP27,** 141, Kobe, Jul. 2009.
281. **Pankaj Koinkar, Daisuke Yonekura, T. G. Kim, M. A. More *and* Ri-ichi Murakami :** Field emission investigation of boron doped diamond thin films synthesized by microwave plasma chemical vapor deposition : Effect of vacuum annealing, *Technical Digest of 2009 22nd International Vacuum Nanoelectronics Conference,* 247-248, Hamamatsu, Jul. 2009.
282. **O. Kojima, S. Watanabe, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Spatial coherence effect on transient response of confined excitons in GaAs thin films, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Th-mP7,** 226, Kobe, Jul. 2009.
283. **Ken Morita, H. Sanada, S. Matsuzaka, Y. Ohno *and* H. Ohno :** Two-color pump-probe measurements of intersubband excitonic interactions in GaAs/AlAs quantum wells, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.M6e,** 204, Kobe, Jul. 2009.
284. **Takahashi Tomoya, Kanbara Toshiyuki, Mukai Takuya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Molecular Beam Epitaxy of InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Layers, *Second International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures (SemicoNano2009),* **Vol.P-19,** Annan, Aug. 2009.
285. **Toshiro Isu, Takahashi Tomoya, Kanbara Toshiyuki, Mukai Takuya, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr Signals of a GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Layers, *Second International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures (SemicoNano2009),* **Vol.O-12,** Annan, Aug. 2009.
286. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer layer doping concentration measurement using VT-VSUB Characterization of GaN HEMT with p-GaN substrate layer, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
287. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *8th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Nagano, Aug. 2009.
288. **Toshiro Isu, Kanbara Toshiyuki, Takahashi Tomoya, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities with two-photon resonant quantum wells in the half-wavelength layer, *The 36th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2009), No.p1.15,* 123, University of California, Santa Barbara, USA, Sep. 2009.
289. **Ken Morita, Niki Nobuyoshi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of two-photon absorption in GaAs/AlGaAs quantum wells measured by photoluminescence, *The 36th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2009), No.p1.13,* 119, University of California, Santa Barbara, USA, Sep. 2009.
290. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masaya Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** MIS Diode Characterization on n-GaN by C-V Measurement at 150 C, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
291. **Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of GaN MOSFET with TEOS SiO2 Gate Insulator, *The 2009 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Sendai, Oct. 2009.
292. **Takahashi Tomoya, Mukai Takuya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers for planar-type optical Kerr gate switches, *2009 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2009),* **Vol.I-6-5,** Sendai, Oct. 2009.
293. **Tanaka Fumiya, Takahashi Tomoya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong sum frequency generation in a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity grown on a (113)B-oriented GaAs substrate, *2009 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2009),* **Vol.I-9-2,** Sendai, Oct. 2009.
294. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Low Resistance Ohmic Contact to Deeply Dry-etched p-GaN, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
295. **Cheng-Yu Hu, Daigo Kikuta, Katsutoshi Nakatani, Jin-Ping Ao, Masahiro Sugimoto *and* Yasuo Ohno :** Monitoring and control of substrate voltage for AlGaN/GaN HEMTs with p-GaN epi-layer, *The 8th International Conference on Nitride Semiconductors,* Cheju, Oct. 2009.
296. **Pangpang Wang, Lumei Gao, Xiaoping Song, Sen Yang, Wang Liqun *and* Ri-ichi Murakami :** Crystal Growth and Magnetic Reversal Mechanism in FerromagneticNanowire by Chain of Prolate Spheroids Model, *General Poster Session,* 153-158, Oct. 2009.
297. **Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Yoshinori Nakagawa, Masuo Fukui, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication of a grating coupler in surface plasmon polariton (SPP) waveguide by scanning probe microscope (SPM) lithography, *Abstract of the 7-th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics (APNFO-7),* 70, Jeju, Nov. 2009.
298. **Takae Yamashita, Osamu Kojima, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Effective dipole moments of excitons in GaAs thin films, *Workshop on Information, Nano and Photonics Technology 2009 (WINPTech 2009),* Kobe, Dec. 2009.
299. **Dong-Hun Kim, Ri-ichi Murakami, Yun-Hae Kim, Kyung-Man Moon, Seung-Jun An *and* Pangpang Wang :** The Characteristics of Multilayer Thin Films Deposited with Metal Thin Films (Ag, Al, Cu), *Advanced Materials Research,* **Vol.97-101,** 1768-1771, Mar. 2010.
300. **野村 英矩, 熊井 亮太, 富田 卓朗, 森田 健, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎 :** シリコン表面上で生成されるリップル構造のパルス数及びフルエンス依存性, *第56回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.56,** *No.3,* 1180, 2009年4月.
301. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** プローブ陽極酸化リソグラフィー法による微細グレーティング加工に関する研究, *第56回応用物理学会学関係連合講演会 講演予稿集,* **Vol.2,** *No.1a-TE-4,* 708, 2009年4月.
302. **桂 修平, 原内 裕司, 米倉 大介, 村上 理一 :** TiN膜の熱処理により作製したTi-O-N膜の光分解特性, *日本材料学会第58期学術講演会,* 193-194, 2009年5月.
303. **井須 俊郎 :** 半導体多層膜共振器を用いた面型全光カーゲートスイッチ, *神戸大学連携推進本部ナノ・フォトニクス技術セミナー,* 2009年5月.
304. **北田 貴弘 :** 超高速光スイッチに向けたInAs量子ドットの分子線エピタキシャル成長, *神戸大学連携推進本部ナノ・フォトニクス技術セミナー,* 2009年5月.
305. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Akari Mukaijo, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in straiu-relaxed barriers for ultrafast all-optical switch, *28th Electronic Materials Symposium(EMS28), No.F4,* 155-156, Jul. 2009.
306. **Fumiya Tanaka, Toshiyuki Kanbara, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Second harmonic and sum frequency generations of a coupled (113)B GaAs/AlAs multilayer cavity, *28th Electronic Materials Symposium(EMS28), No.J21,* 277-278, Jul. 2009.
307. **高橋 朋也, 向井 拓也, 向所 明里, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バイア層に埋め込んだInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器, *応用物理学会中国四国支部2009年度支部学術講演会,* **Vol.Dp2-2,** 97, 2009年8月.
308. **田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2つの共振器モードを有するGaAs/AlAs結合共振器構造による周波数混合信号の発生, *応用物理学会中国四国支部2009年度支部学術講演会,* **Vol.Dp2-3,** 98, 2009年8月.
309. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 胡 成余, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスのステップストレス測定, *第70回応用物理学会学術講演会,* 2009年9月.
310. **下村 輝, 粟井 郁雄, 大野 泰夫 :** ミリはインターコネクトにおける設置面の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
311. **高橋 健介, 敖 金平, 胡 成余, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 大野 泰夫 :** マイクロ波電力整流用GaNショットキーダイオードのSパラメータ解析, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
312. **倉本 健次, 阿部 まみ, 奥山 祐加, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器を用いた非接触広帯域入出力インターフェイス, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
313. **阿部 まみ, 倉本 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *2009年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* 2009年9月.
314. **出来 真斗, 山本 稔, 伊藤 拓人, 岩見 勝弘, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** イオン注入電極を作製したSiC基板へのフェムト秒レーザー照射による電気伝導特性制御, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会・講演予稿集,* 1057, 2009年9月.
315. **北田 貴弘, 田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜結合共振器内部における2つの共振器モードの光干渉効果, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-5,* 1286, 2009年9月.
316. **高橋 朋也, 田中 文也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/Air 多層膜共振器の光カー信号強度のシミュレーション, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-2,* 1285, 2009年9月.
317. **田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs (113)B 結合共振器における和周波信号強度の励起偏光方向依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-6,* 1287, 2009年9月.
318. **森田 健, 高橋 朋也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器におけるps パルスを用いた光カー信号のQ 値依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-1,* 1285, 2009年9月.
319. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 走査型プローブ顕微鏡リソグラフィーによる回折格子型表面プラズモン励起素子の作製, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9a-ZM-6,* 946, 2009年9月.
320. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだSi ドープInAs 量子ドットにおけるキャリア緩和の励起波長依存性, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会, No.10p-C-14,* 315, 2009年9月.
321. **森田 健, 高橋 朋也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜共振器における光カー信号の励起光強度依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.10p-C-13,* 314, 2009年9月.
322. **谷本 翔太, 米倉 大介, 村上 理一 :** CrN 薄膜を被覆したTi-6Al-4V 合金のフレッティング疲労特性, *日本機械学会2009年度年次大会講演論文集,* **Vol.4,** 167-168, 2009年9月.
323. **山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜の励起子非線形光学応答制御における第一パルス光強度依存性, *日本物理学会2009年秋季大会, No.27aPS-28,* 2009年9月.
324. **山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の双極子モーメント, *第20回光物性研究会, No.A-83,* 341, 2009年12月.
325. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 山本 稔, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** 6H-SiC基板へのフェムト秒レーザー改質による電気伝導のパルスピッチ依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会講演会予稿集,* **Vol.18,** 148-149, 2009年12月.
326. **北田 貴弘, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs量子ドットをもつGaAs/AlAs多層膜光共振器による面型全光スイッチ, *2010年光エレクトロニクス研究会,* **Vol.109,** *No.401,* OPE2009-189, 2010年1月.
327. **大野 泰夫 :** 無線送電とワイドギャップ半導体, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
328. **阿部 まみ, 倉本 健次, 天羽 孝文, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 誘電率の異なる基板間でのオープンリング共振器無線接続, *2010年電子情報通信学会総合大会,* 2010年3月.
329. **北田 貴弘, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットにおける高速キャリア緩和, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.17p-TW-14,* 2010年3月.
330. **田中 文也, 高橋 朋也, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2つの共振器モードを有する(113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器の時間分解和周波信号測定, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.17a-TM-22,* 2010年3月.
331. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** 回折格子型表面プラズモンポラリトン励起素子の特性, *第57回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集,* **Vol.17a-P1-21,** 2010年3月.
332. **森田 健, 田中 文也, 高橋 朋也, 滝本 隼主, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2パルスによる(113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の和周波・第二高調波スペクトルの遅延時間依存性, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-M-1,* 2010年3月.
333. **森田 健, 高橋 朋也, 田中 文也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ピコ秒パルスを用いたInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器構造の光カー信号, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-N-7,* 2010年3月.
334. **高橋 朋也, 田中 文也, 張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングによるGaAs/Air多層膜共振器構造の作製, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-TM-24,* 2010年3月.
335. **中谷 克俊, 祖川 雄司, 金 栄現, 敖 金平, 大野 泰夫, 宮下 準弘, 本山 慎一 :** プラズマCVD酸化膜を用いたGaN MOSFET, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
336. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電流コラプスにおける光照射の影響, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2010年3月.
337. **森田 健 :** GaAs/AlAs非結合・結合共振器構造を利用した非線形ダイナミクス, *イーグル若手研究会,* 2010年3月.
338. **北田 貴弘 :** InAs量子ドットとGaAs/AlAs多層膜共振器構造の超高速光スイッチ, *第4回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2010年3月.
339. **森田 健 :** 多層膜結合光共振器構造による周波数混合信号の発生, *第4回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2010年3月.
340. **大野 泰夫 :** 化合物半導体電子デバイス開発の軌跡, *電子情報通信学会シリコン材料・デバイス研究会資料,* 2009年6月.
341. **野崎 兼史, 高橋 義也, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンゲートAlGaN/GaN HFETの電解質溶液を介した電流制御, *電子情報通信学会センサーデバイス・MEMS・一般研究会,* 2009年7月.
342. **黒田 健太郎, 井川 裕介, 光山 健太, 敖 金平, 大野 泰夫 :** ステップストレス測定によるAlGaN/GaN HFET電流コラプス解析, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
343. **高橋 健介, 敖 金平, 篠原 真毅, 丹羽 直幹, 藤原 暉雄, 大野 泰夫 :** マイク ロ波無線ユビキタス電源用GaNショットキーダイオードの開発, *電子情報通信学会電子デバイス，電子部品・材料，レーザ・量子エレクトロニクス研究会,* 2009年11月.
344. **Pankaj Koinkar *and* Ri-ichi Murakami :** Internationalization of Graduate Education, *Fourth International Symposium: Development of the Global Double Degree Program, The University of Tokushima,* Dec. 2009.
345. **Pankaj Koinkar *and* Ri-ichi Murakami :** Analysis and review of Summer school program and Short-term study abroad program, *22 FD in,* Jan. 2010.
346. **Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong Sum Frequency Generation in a GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity Grown on a (113)B-Oriented GaAs Substrate, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DG01, 2010.
347. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Planar-Type Optical Kerr Gate Switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DG02, 2010.
348. **Cheng-Yu Hu, Hiroyuki Nokubo, Masanari Okada, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Metal Insulator Semiconductor Diode Characterization on n-GaN by Capacitance Voltage Measurement at 150 °C, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF11, 2010.
349. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Keisuke Ohmuro, Masahiro Sugimoto, Cheng-Yu Hu, Yuji Sogawa *and* Yasuo Ohno :** GaN Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor with Tetraethylorthosilicate SiO2 Gate Insulator on AlGaN/GaN Heterostructure, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DF09-1-04DF09-4, 2010.
350. **Shamimur Md. Rahman, T. Katsuma, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Evaluation of crack initiation and fatigue behavior of CrN film deposited on Ti-6Al-4V alloy, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.24,** *No.15n16,* 2502-2505, 2010.
351. **S. Fukui, Daisuke Yonekura *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of Deposition Conditions on Fatigue Properties of Martensitic Stainless Steel with TiN Film Coated by Arc Ion Plating Method, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.24,** *No.15-16,* 3095-3100, 2010.
352. **Dongyan Zhang, Pangpang Wang, Ri-ichi Murakami *and* Song Xiaoping :** Effect of an interface charge density wave on surface plasmon resonance in ZnO/Ag/ZnO thin films, *Applied Physics Letters,* **Vol.96,** *No.23,* 233114, 2010.
353. **Pangpang Wang, Lumei Gao, Liqun Wang, Dongyan Zhang, Sen Yang, Xiaoping Song, Zhiyong Qiu *and* Ri-ichi Murakami :** MAGNETIC PROPERTIES OF FENI NANOWIRE ARRAYS ASSEMBLED ON POROUS AAO TEMPLATE BY AC ELECTRODEPOSITION, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.24,** *No.15n16,* 2302-2307, 2010.
354. **Lee J. C., Ri-ichi Murakami *and* Suh M. C. :** FATIGUE PROPERIES OF ALUMINUM ALLOY(A6061-T6) WITH ULTRASONIC NANO-CRYSTAL SURFACE MODIFICATION, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.24,** *No.15,* 2512-2517, 2010.
355. **Cao J. X., Ri-ichi Murakami *and* Wang Y. Q. :** FATIGUE PROPERTIES OF Ti-6Al-4V SUBJECTED TO 0.9% PHYSIOLOGICAL SALINE SOLUTION, *International Journal of Modern Physics B,* **Vol.24,** *No.15,* 2518-2523, 2010.
356. **Jin-Ping Ao, Asato Suzuki, Kouichi Sawada, Satoko Shinkai, Yoshiki Naoi *and* Yasuo Ohno :** Schottky contacts of refractory metal nitrides on gallium nitride using reactive sputtering, *Vacuum,* **Vol.84,** *No.12,* 1439-1443, 2010.
357. **米倉 大介, 高橋 雅也, 村上 理一, 加藤 雅裕, 大西 賢治 :** シリカ粉体の付着・堆積挙動に及ぼす鋼板表面研磨処理の影響, *日本機械学会論文集(C編),* **Vol.76,** *No.767,* 1838-1843, 2010年.
358. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strongly Enhanced Sum Frequency Generation in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Applied Physics Express,* **Vol.3,** *No.7,* 072801, 2010.
359. **Cao X.J., Pyoun Y.S. *and* Ri-ichi Murakami :** Fatigue properties of a S45C steel subjected to ultrasonic nanocrystal surface modification, *Applied Surface Science,* **Vol.256,** *No.21,* 6297-6303, 2010.
360. **Chang Huang, Pangpang Wang, Wen Guan, Sen Yang, Lumei Gao, Liqun Wang, Xiaoping Song *and* Ri-ichi Murakami :** Improved microstructure and magnetic properties of ironcobalt nanowire via an ac electrodeposition with a multistep voltage, *Materials Letters,* **Vol.64,** *No.22,* 2465-2467, 2010.
361. **Krishal Patel, Colin S. Doyle, Daisuke Yonekura *and* Bryony J. James :** Effect of surface roughness parameters on thermally sprayed PEEK coatings, *Surface & Coatings Technology,* **Vol.204,** *No.21-22,* 3567-3572, 2010.
362. **Ken Morita, Nobuyoshi Niki, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of two-photon absorption in GaAs/AlGaAs quantum wells measured by photoluminescence, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.10,* 2482-2485, 2010.
363. **Toshiro Isu, Toshiyuki Kanbara, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities with two-photon resonant quantum wells in the half-wavelength layer, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.10,* 2478-2481, 2010.
364. **Daisuke Yonekura, Katsuhiro Fujikawa *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of film structure on gas barrier properties of SiOxNy films, *Surface & Coatings Technology,* **Vol.205,** *No.1,* 168-173, 2010.
365. **Yusuke Ikawa, Yorihide Yuasa, Cheng-Yu Hu, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** 2D Device Simulation of AlGaN/GaN HFET Current Collapse Caused by Surface Negative Charge Injection, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1218-1224, 2010.
366. **Cheng-Yu Hu, Katsutoshi Nakatani, Hiroji Kawai, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Buffer Layer Doping Concentration Measurement Using VT-VSUB Characteristics of GaN HEMT with p-GaN Substrate Layer, *IEICE Transactions on Electronics,* **Vol.E93-C,** *No.8,* 1234-1237, 2010.
367. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Doping effect on photocarrier lifetime in InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers grown by molecular beam epitaxy, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.42,** *No.10,* 2540-2543, 2010.
368. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Toshiyuki Kanbara, Shinsuke Yano, Takuya Mukai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Large optical Kerr signal of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.42,** *No.10,* 2505-2508, 2010.
369. **Dongyan Zhang, Pangpang Wang, Ri-ichi Murakami *and* Song Xiaoping :** Response to Comment on Enhancement of light transmission by coupling to surface plasmon polaritons of a layer-plus-islands silver layer [ J. Appl. Phys. 106, 103104 (2009) ], *Journal of Applied Physics,* **Vol.108,** *No.8,* 086103-086104, 2010.
370. **Pangpang Wang, Dongyan Zhang, Huang Chang, Song Xiaoping *and* Ri-ichi Murakami :** Surface Plasmon Resonant Enhanced Optical Transmission through ZnO/Ag/ZnO Multilayered Films, *Advances in Materials Science for Environmental and Nuclear Technology,* **Vol.222,** 287-294, 2010.
371. **Pankaj Koinkar, Sandip S. Patil, Tae-Gyu Kim, Daisuke Yonekura, Mahendra A. More, Dilip S. Joag *and* Ri-ichi Murakami :** Enhanced field emission characteristics of boron doped diamond films grown by microwave plasma assisted chemical vapor deposition, *Applied Surface Science,* **Vol.257,** *No.6,* 1854-1858, 2011.
372. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *Journal of Physics: Conference Series,* **Vol.276,** *No.1,* 012001-1-012001-4, 2011.
373. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Shiro Akamatsu, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with a gate SiO2 insulator deposited by silane-based plasma-enhanced chemical vapor deposition, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 457-460, 2011.
374. **Dongyan Zhang, Pangpang Wang, Ri-ichi Murakami *and* Song Xiaoping :** First-principles simulation and experimental evidence for improvement of transmittance in ZnO films, *Progress in Natural Science : Materials International,* **Vol.21,** *No.1,* 40-45, 2011.
375. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of photocarrier relaxation in Si-doped InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 334-336, 2011.
376. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation Velocity of Excitonic Polaritons Confined in GaAs Thin Films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 378-380, 2011.
377. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Dephasing of excitonic polaritons confined in GaAs thin films, *Journal of the Physical Society of Japan,* **Vol.80,** *No.3,* 034704-1-034704-5, 2011.
378. **Yun-Hae Kim, Young-Dae Jo *and* Ri-ichi Murakami :** A computational analysis of the scarf angle on a composites repair, *International Journal of Ocean System Engineering,* **Vol.1,** *No.1,* 9-15, 2011.
379. **米倉 大介, 高橋 雅也, 村上 理一, 加藤 雅裕, 大西 賢治 :** 表面研磨処理を施した鋼板の粉体付着抑制効果に及ぼす粒子径の影響, *日本機械学会論文集(C編),* **Vol.77,** *No.775,* 1161-1170, 2011年.
380. **Manato Deki, Takuto Ito, Minoru Yamamoto, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Enhancement of local electrical conductivities in SiC by femtosecond laser modification, *Applied Physics Letters,* **Vol.98,** *No.13,* 133104-1-133104-3, 2011.
381. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Flockert Michael, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton excitation by a Phase Shift Grating, *World Academy of Science Engineering and Technology,* **Vol.74,** 24-28, 2011.
382. **米倉 大介, 村上 理一 :** PVDコーティング材のフレッチング疲労, *トライボロジスト,* **Vol.55,** *No.10,* 708-713, 2010年10月.
383. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong optical Kerr gate signal in InAs-dot-buried GaAs/AlAs multilayer cavity using a picosecond laser pulse, *Quantum Dot 2010, No.p.57,* East Midlands Conference Center,Nottingham,UK, Apr. 2010.
384. **Jin-Ping Ao, Katsutoshi Nakatani, Yuji Sogawa, Young Hyun Kim, Takahiro Miyashita, Shin-ichi Motoyama *and* Yasuo Ohno :** GaN MOSFET with Gate SiO2 Deposited by Silane-Based PECVD, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors,* Takamatsu, May 2010.
385. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation Velocity of Excitonic Polaritons Confined in GaAs Thin Films, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrE1-4,* 353, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
386. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Excitation Wavelength Dependence of Photocarrier Relaxation in Si-Doped InAs Quantum Dots with Strain-Relaxed InGaAs Barriers, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrP15,* 377, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
387. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Enhanced Sum-Frequency Generation Signal in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrP18,* 379, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
388. **Daisuke Yonekura, Yuta Fujie, Hayato Nishii, Hiroshi Yamakawa *and* Ri-ichi Murakami :** Influence of Heat Treatment on Fatigue Strength of Drawn Steel Tubes for Small-sized Single Pass Boiler, *International Conference on Structural Integrity and Failure 2010,* Auckland, Jul. 2010.
389. **Cao Xiaojian, Yan Fan, Ri-ichi Murakami *and* Onizawa Atsushi :** Fatigue Properties of a S45C Steel with Plasma Nitriding, *International Conference for SIF2010,* Jul. 2010.
390. **Toshiro Isu, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Toshikazu Takimoto, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Frequency-M-xing-Signal Generation on a GaAs/AlAs Coupled Multilayer-Cavity, *9th International Conference on Excitonic and Photonic Processws in Condensed and Nano Materials (EXCON'10),* **Vol.13O02,** Novotel Hotel, Brisbane, Australia, Jul. 2010.
391. **Manato Deki, Minoru Yamamoto, Ito Takuto, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Femtosecond laser modification aiming at the enhancement of local electric conductivities in SiC, *30th International Conference on the Physics of Semiconductors,* P1-306, Seoul, Jul. 2010.
392. **Takahiro Kitada, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked reduction in photocarrier lifetime by erbium doping into self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *16th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2010), No.p1.20,* bcc Berlin Congress Center, Berlin, Germany, Aug. 2010.
393. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Flockert Michael, Toshihiro Okamoto, Masuo Fukui, Toshiro Isu, T Okazaki *and* Gen-ichi Shinomiya :** Modulator for Surface Plasmon Polariton Using LiNbO3:Ti Plasmon Waveguide, *11th International Conference on Near-field Nano Optics, Nanophotonics& Related Techniques (NFO-11),* Beijing, Aug. 2010.
394. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Remarkable Enhancement of Optical Kerr Signal by increasing Quality Factor in a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010), No.D-1-4,* 59-60, Tokyo, Sep. 2010.
395. **Fumiya Tanaka, Toshikazu Takimoto, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-Resolved Measurements on Sum Frequency Generation Strongly Enhanced in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010), No.D-2-1,* 61-62, Tokyo, Sep. 2010.
396. **Mami Abe, Takahumi Amou, Kenji Kuramoto, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effects of Substrate Conductivity on Open-Ring Resonator Wireless Interconnection, *2010 Asia-Pacific Radio Science Conference,* Toyama, Sep. 2010.
397. **Ri-ichi Murakami :** Improvement of Optical Transmission and Conductivity in a Symmmetric Zno/Ag Multilayered films, *The 11th IUMRS International Conference in Asia,* Sep. 2010.
398. **Jin-Ping Ao, Kensuke Takahashi, Naoki Shinohara, Naoki Niwa, Teruo Fujiwara *and* Yasuo Ohno :** S-parameter Analysis of GaN Schottky Diodes for Microwave Power Rectification, *2010 IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium,* Monterey, Oct. 2010.
399. **Manato Deki, Takuro Ito, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Oshima :** Laser Modification Aiming at the Enhancement of Local Electrical Conductivities in SiC, *The 9th International Workshop on Radiation Effects on Semiconductor Devices for Space Applications,* 218-221, Takasaki, Oct. 2010.
400. **Jin-Ping Ao :** Monolithic Integration of GaN-based LEDs, *2nd Photonics and Optoelectronics Meetings (POEM2010),* Wuhan, Nov. 2010.
401. **Ri-ichi Murakami :** Improvement Mechanism of Extraordinary Optical Transmission in a Dielectric/metal/dielectric Multilayer Thin Films, *2010 Inetrnational Conference on Optics and Photonics in Taiwan,* Tainan, Dec. 2010.
402. **Mami Abe, Yuka Okuyama, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Misalignment Effects in Inter-Chip Wireless Connection with Open-Ring Resonators, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
403. **Yasuo Ohno :** Application of GaN Devices to Wireless Power Transmission, *2010 Asia-Pacific Microwave Conference (APM C2010),* Yokohama, Dec. 2010.
404. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel terahertz emission devices based on efficient optical frequency conversion in GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures on high-index substrates, *SPIE Photonics West2011, No.OPTO7937-52,* The Moscone Center San Francisco, California, USA, Jan. 2011.
405. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Flockert Michael, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton excitation by a Phase Shift Grating, *International Conference on Nanotechnology, Optoelectronics and Photonics (ICNOP) 2011,* 24, PENANG,MALAYSIA, Feb. 2011.
406. **原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** ナノLEDの開発, *LED総合フォーラム論文集,* 67-68, 2010年4月.
407. **Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of sum-frequency generation in a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *29th Electronic Materials Symposium (EMS-29), No.We3-5,* 57, Jul. 2010.
408. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr gate switching in InAs-dot-buried GaAs/AlAs multilayer cavity using a wavelength restricted picosecond laser pulse, *29th Electronic Materials Symposium (EMS-29), No.We3-7,* 61, Jul. 2010.
409. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトンを利用したレジスト厚計測, *応用物理学会 中国四国支部 2010年度 支部学術講演会, No.Aa2-5,* 2010年7月.
410. **田辺 新平, 中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトンを利用したグルコースセンサー, *応用物理学会 中国四国支部 2010年度 支部学術講演会, No.Aa2-4,* 2010年7月.
411. **阿部 まみ, 敖 金平, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器無線接続における基板抵抗の影響, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
412. **原内 健次, 細川 大志, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードのSパラメータ解析, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
413. **細川 大志, 原内 健次, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN横型ショットキーダイオードの二次元デバイスシミュレーション, *第71回応用物理学会学術講演会,* 2010年9月.
414. **薄木 航, 米倉 大介, 村上 理一 :** ナノインデンテーション法を用いたPVD 薄膜の破壊靭性の評価, *日本機械学会2010年度年次大会講演論文集,* **Vol.1,** 313-314, 2010年9月.
415. **谷本 翔太, 米倉 大介, 村上 理一 :** 硬質薄膜を被覆したチタン合金のフレッティング疲労特性, *日本機械学会2010年度年次大会講演論文集,* **Vol.1,** 315-316, 2010年9月.
416. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における局所電気伝導度の照射フルエンス依存性, *第71 回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* 04-269, 2010年9月.
417. **森田 健, 田中 文也, 滝本 隼主, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分極反転したGaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の作製とその光学特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.14a-G-3,* 05-041, 2010年9月.
418. **上山 日向, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットの電気特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.15a-ZV-4,* 15-058, 2010年9月.
419. **田中 文也, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 非対称なGaAs/AlAs多層膜結合共振器の作製とその光学特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-7,* 14-070, 2010年9月.
420. **北田 貴弘, 田中 文也, 滝本 隼主, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器における非線形分極構造の制御, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-6,* 14-069, 2010年9月.
421. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜におけるレーザースペクトル幅制御による励起子応答制御, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-8,* 14-071, 2010年9月.
422. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン励起のためのスラブ導波路上の位相シフト回折格子結合器の評価, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.17a-NJ-6,* 03-140, 2010年9月.
423. **五井 恵太, 山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子状態の制御性, *2010年秋季大会 日本物理学会, No.25pPSB-31,* 731, 2010年9月.
424. **小林 大士, 米倉 大介, 村上 理一 :** SiOxNy膜を被覆したガスケット用ゴムシートの熱酸化劣化特性, *日本機械学会中国四国支部・九州支部合同企画 徳島講演会講演論文集, No.105-2,* 23-24, 2010年10月.
425. **能田 光, 米倉 大介, 村上 理一 :** アルミニウム合金基板に被覆したCrN薄膜の密着性に及ぼす基板前処理の影響, *日本機械学会中国四国支部・九州支部合同企画 徳島講演会講演論文集, No.105-2,* 25-26, 2010年10月.
426. **石川 洋三, 米倉 大介, 村上 理一 :** MPCVD法により成膜した導電性ダイヤモンド薄膜の表面化学修飾の評価, *日本機械学会中国四国支部・九州支部合同企画 徳島講演会講演論文集, No.105-2,* 27-28, 2010年10月.
427. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー改質したSiCにおける局所電気伝導度の照射フルエンス依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第19回講演会 予稿集,* 114-115, 2010年10月.
428. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における局所電気伝導度の照射偏光依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第19回講演会 予稿集,* 110-111, 2010年10月.
429. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子応答に対する検出パルスのスペクトル幅の効果, *WINPTech2010 Workshop on Information, Nano and Photonics Technology 2010,* 2010年12月.
430. **五井 恵太, 小島 磨, 山下 太香恵, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子状態の光制御, *第21回光物性研究会(2010), No.A-57,* 2010年12月.
431. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 検出パルス制御によるGaAs薄膜中の閉じ込め励起子の超高速応答, *第21回光物性研究会(2010), No.A-84,* 2010年12月.
432. **森田 健 :** 量子ドットを用いた面型多層膜超高速全光スイッチ, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2011年2月.
433. **北田 貴弘 :** 半導体結合光共振器によるテラヘルツ光発生素子, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2011年2月.
434. **原内 健次, 岩崎 裕一, 阿部 まみ, 敖 金平, 篠原 真毅, 外村 博史, 大野 泰夫 :** オープンリング共振器接続によるマイクロ波無線電力伝送, *2011年電子情報通信学会総合大会,* 2011年3月.
435. **細川 大志, 黒田 健太郎, 井谷 祥之, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流コラプスの回復過程測定, *第57回応用物理学関係連合講演会,* 2011年3月.
436. **森田 健, 加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 多層膜結合共振器構造へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.24a-KF-4,* 04-157, 2011年3月.
437. **上山 日向, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットの作製とその光学特性, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.24p-BQ-4,* 15-061, 2011年3月.
438. **西中 一平, 美藤 邦彦, 木股 雅章, 内藤 聖貴, 山本 泰志, 片山 晴善, 佐藤 亮太, Patrashin Mikhail, 寳迫 巌, 井須 俊郎, 北田 貴弘 :** GaSb/InAs Type-II超格子赤外線センサの開発, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KT-7,* 03-063, 2011年3月.
439. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 重心運動閉じ込め励起子の量子ビートの生成と検出, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-7,* 14-040, 2011年3月.
440. **北田 貴弘, 安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜三結合共振器の面型波長変換素子への応用, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-8,* 14-041, 2011年3月.
441. **滝本 隼主, 加藤 翔, 田中 文也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合により作製したGaAs/AlAs多層膜結合共振器, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-9,* 14-042, 2011年3月.
442. **中田 智康, 中河 義典, 田邉 新平, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン励起のためのブレーズド回折格子結合器の評価, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-3,* 03-188, 2011年3月.
443. **田邉 新平, 中河 義典, 中田 智康, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 二次元六方クラスター回折格子による表面プラズモン励起, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-4,* 03-189, 2011年3月.
444. **Michael Flockert, 田邉 新平, 中河 義典, 中田 智康, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 小山 浩司, 四宮 源市 :** 二次元矩形クラスタープラズモニック格子による表面プラズモン励起, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-5,* 03-190, 2011年3月.
445. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射偏光依存性, *第58回応用物理学関係連合講演会,* 04-287, 2011年3月.
446. **加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の二つの共振器モードを利用したテラヘルツ帯差周波発生, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.26a-KB-2,* 05-106, 2011年3月.
447. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射強度および偏光依存性, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム 「日亜寄附講座研究成果報告会」,* 10, 2011年2月.
448. **加藤 雅裕, 米倉 大介, 高橋 雅也 :** 新しい付着抑制表面処理を施した鋼表面への粉体の付着挙動の解析, *徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部研究報告, No.55,* 19-24, 2010年6月.